

Разработка использует метод лазерно-индуцированной разрядной плазмы (LDP), который отличается от традиционной технологии ASML. Новый подход упрощает конструкцию оборудования, делает его более энергоэффективным и снижает затраты на производство. По предварительным данным, массовое производство таких машин может начаться в 2026 году.

Крупный китайский производитель чипов SMIC до сих пор испытывает трудности с массовым выпуском 5-нм полупроводников из-за высоких затрат и низкой производительности. Это также ограничивает возможности Huawei, которая пока не может преодолеть рубеж в 7 нм. Новое оборудование, разрабатываемое в Китае, позволит использовать передовую 13,5-нм EUV-литографию, что существенно ускорит развитие полупроводниковой отрасли страны.

Испытания прототипа уже ведутся в исследовательском центре Huawei в Дунгуане. Сообщается, что система использует метод испарения олова между электродами с последующей ионизацией плазмы при высоком напряжении. Этот процесс более доступен и менее энергозатратен по сравнению с европейскими аналогами, что делает технологию перспективной для массового внедрения.